Резонансные процессы в активной среде

Д.А. Румянцев*, Д.М. Шленев** А.А. Ярков*** Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Россия

В работе рассмотрены различные квантовые процессы с учетом резонанса на виртуальном фермионе.

^{*}E-mail: rda@uniyar.ac.ru

^{**}E-mail:

^{***}E-mail: a12l@mail.ru

1 Введение

2 Резонансные эффекты

Присутствие активной среды (магнитного поля и/или плазмы) приводит к изменению амплитуд микропроцессов, вследствие чего они могут приобретать резонансный характер. Возможны два типа резонанса: на виртуальном заряженном и виртуальном фотоне. Вследствие резонанса вклад микропроцессов в макроскопические характеристики астрофизических процессов, такие как светимость и скорость изменения количества частиц, может многократно увеличиваться.

3 Резонанс на виртуальном заряженном фермионе

В сильном магнитном поле поперечная составляющая импульса фермиона квантуется. В таком случае энергия фермиона определяется так называемым уровнем Ландау n и проекцией импульса вдоль магнитного поля p_z :

$$E_n = \sqrt{1 + p_z^2 + 2\beta n},\tag{1}$$

где введено обозначение $\beta = |e_f|B, e_f$ - заряд фермиона. В пропагаторе виртуального фермиона имеется конструкция вида:

$$\frac{1}{p_{\parallel}^2 - m_f^2 - 2\beta n - \Re_{\Sigma}^s(p) + i \Im_{\Sigma}^s(p)}.$$
 (2)

Возникающие в знаменателе пропагатора реальная $\Re_{\Sigma}^{s}(p)$ и мнимая $\Im_{\Sigma}^{s}(p)$ части, соответствующие поляризационному состоянию s, есть результат вычисления радиационных поправок к массе фермиона в замагниченной плазме. Мнимая часть $\Im_{\Sigma}^{s}(p)$ может быть получена с помощью оптической теоремы и представлена в следующем виде [?,?]:

$$\mathfrak{S}_{\Sigma}^{s}(p) = -\frac{1}{2} p_0 \, \Gamma_n^s \,, \tag{3}$$

где Γ_n^s – вероятность изменения состояния фермиона, находящегося в поляризационном состоянии s и занимающего n-й уровень Ландау.

Реальная часть массового оператора $\mathcal{R}^s_{\Sigma}(p)$ определяет изменение (по сравнению с вакуумным) закона дисперсии фермиона в присутствии замагниченной плазмы. В слабых магнитных полях, $B \ll B_e$, она определяется отношением [?]:

$$\Re_{\Sigma}^{s}(p) = \frac{4\alpha m_{f}}{3\pi} \varkappa^{2} \left[\ln \varkappa^{-1} + C + \frac{1}{2} \ln 3 - \frac{33}{16} \right], \quad \varkappa \ll 1, \tag{4}$$

где C=0.577... - постоянная Эйлера, динамический параметр \varkappa вводится следующим образом:

$$\varkappa = \frac{1}{m_f B_e} [-(F_{\mu\nu} p_{\nu})^2]^{1/2}.$$
 (5)

В сильных магнитных полях, $B \gtrsim B_e$, сдвиг массы фермиона в основном состоянии описывается дважды логарифмической асимптотикой [?]:

$$\Re_{\Sigma}^{s}(p) = \frac{\alpha}{4\pi} m_f \ln^2(2\beta). \tag{6}$$

Из (4) и (6) следует, что как в слабых, так и в относительно сильных ($B_e \lesssim B \lesssim 10^{16} \, \Gamma c$) магнитных полях поправка к массе фермиона, обусловленная вкладом $\Re_{\Sigma}^s(p)$, оказывается несущественной [1, 2].

Резонанс на фиртуальном фермионе имеет место быть в условиях, при которых возбуждаются высшие (n > 0) уровни Ландау виртуального фермиона. При этом возможна ситуация, при которой реальная часть знаменателя пропагатора виртуального фермиона обращается в ноль. В этом случае виртуальный фермион становится реальным с определённым законом дисперсии, находится на массовой поверхности. Амплитуда процесса с участием виртуального фермиона в промежуточном состоянии при этом значительно увеличивается и определяется мнимой частью массового оператора (3).

Среди резонансных процессов особый интерес представляют одно-, двухи трёхвершинные процессы, поскольку существенное влияние на характеристики астрофизических процессов будут оказывать только реакции, дающие лидирующие по константам связи вклады.

Одновершинные процессы, будучи в замагниченной среде, становятся кинематически разрешены. Особенностью данных процессов можно отметить жесткие кинематические ограничения. Одним из таких процессов является $npoyecc\ poxedenus\ \phiomona\ e \to e\gamma$, также называемый циклотронным или синхотронным излучением. При высоких магнитных полях излучение обусловлено переходами на более низкие уровни Ландау. Следует отметить, что при очень сильных магнитных полях, когда $\beta \sim 0.2$, электроны, находящиеся на более высоких уровнях Ландау, переходят непосредственно на основной уровень, а не на соседний. С другой стороны обратный к процессу рождения фотона npoyecc nornowenus фотона $e\gamma \to e$ приводит к переходу электрона на высшие уровни Ландау. Другой немаловажный квантовый процесс является Процесс однофотонного рождения электрон-позитронной $napы \ \gamma \to e^+e^-$. Особенностью данного процесса является то, что фотон эффективно распадается вблизи точек циклотронного резонанса, где поляризационный оператор фотона имеет сингулярности. Однако является подавленным в области ниже порога рождения $\hbar\omega=2mc^2$.

Двухвершинные процессы. Типичным примером двухвершинного процесса является комптоновский процесс $e\gamma \to e\gamma$. Вблизи циклотронных резонансов сечение комптоновского рассеяния, без учета конечной ширины поголощения электрона, становится бесконечным. В таком случае промежуточный (виртуальный) электрон становится реальным, т.е. его закон дисперсии соответствует массовой поверхности, а комптоновский процесс становится одновершинным процессом. Процесс обратного комптоновского рассеяния может быть эффективным механизмом генерации жёсткого рентгеновского излучения сильно замагниченных нейтронных звёзд. Учёт резонансов в процессе комптоновского рассеяния необходим при построении моделей остывания магнитаров.

Большое магнитное поле может индуцировать новые взаимодействия частиц. Таким образом могут возникать такие фотон-нейтринные процессы, как конверсия фотона в пару нейтрино-антинейтрино $\gamma \to \nu \bar{\nu}$ или излучение

фотона нейтрино $\nu \to \nu \gamma$. Такие процессы имеют петлевую диаграмму с двумя виртуальными электронами и вершинами как слабого, так и электромагнитного взаимодействия. При плотностях порядка $\rho = 10^9 \ r/cm^3$ начинают возбуждаться высшие уровни Ландау виртуального электрона в фотонейтринном комптоноподобном процессе $\gamma e \to e \nu \bar{\nu}$, в результате чего он приобретает резонансный характер. Это может приводить к увеличению эффективности этой реакции, вследствие чего она, наряду с $\gamma \to \nu \bar{\nu}$, может играть важную роль в остывании нейтронных звезд.

Среди петлевых двухвершинных процессов особое место занимает поляризационный оператор фотона во внешнме поле. Именно он определяет изменение поляризационных и дисперсионных свойств фотона во внешней активной среде. При изучении резонансных эффектов в магнитном поле и плазме оказывается важным учёт радиационных поправок к массе фермиона, что сводится к рассчёту массового оператора фермиона как ещё одной петлевой двухвершинной диаграммы.

Кроме этого, интерес представляют процессы с участием гипотетических частиц, таких как аксион – наиболее веротяный кандидат на роль холодной тёмной материи. Возможным механизмом генерации аксионов является резонансный процесс фоторождения на заряженных компонентах среды, $i \to f + a$.

Трехвершинные процессы. Кроме того в остывании нейтронных звёзд также играет роль трехвершинный *процесс двухфотонной аннигиляции* $\gamma\gamma \to \nu\bar{\nu}$. Среди электромагнитных процессов не менее интересным процессом является *процесс рождения электрон-позитронной пары* $\gamma e \to e e^+ e^-$, который может быть достаточно эффективным для производства $e^+ e^-$ -плазмы, в то время, как стандартный механизм при аккуратном учете дисперсионных свойств фотонов становится невозможным. Данный процесс также интересен тем, что в нем наблюдаются резонансы как на виртуальном электроне, так и на виртуальном фотоне. С точки зрения формирования спектра нейтронных звёзд важным является учет трехвершинного *процесса расщепления фотона*

 $\gamma \to \gamma \gamma$ и процесс слияния фотонов $\gamma \gamma \to \gamma$, которые выступают, как механизм изменения числа фотонов. При определенных условиях эти процессы могут конкурировать с комптоновским процессом.

4 Заключение

Список литературы

- [1] Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. Electroweak processes in external electromagnetic fields. New York: Springer-Verlag, 2003. 120 p.
- [2] Соколов А. А., Тернов И. М. Релятивистский электрон. Москва: Наука, 1983. 304 с.